

1. Solid-State Electron, nr. 7, v. 38, 1995, Ho Wen-Jeng, Dai Ting-Arn, Chuang Zuon-Ming, Lin Wei, Tu Yuan-Kuang, Wu Meng-Chyi, "InGaAs PIN photodiodes on semiinsulating InP substrates with bandwidth exceeding 14 Ghz", p. 1295-1298.
2. Electrotehn. electron. și automat. Autom. și electron., nr. 2, v. 36, 1992, Rusu Emil, Nan Stelian, Purica Munizer, Budeanu Elena, Cobzarencu Vasile, "Fotodiodă PIN pe InGaAs/InP pentru detecția radiației de 1,3-1,6 μm ", p. 69-71.
3. Appl. Phys. Lett, nr. 19, v. 60, 1992, I. Grave, A. Shakouri, N. Kuze, A. Yariv, "Voltage-controlled tunable GaAs/AlGaAs multistack quantum well infra-red detector", p. 2362-2364.
4. Electron. Lett. nr. 28, v. 28, 1992, V. Berger, N. Voldjdani. "Quantum well infra-red photodetector response controlled by very low power visible source", p. 1980-1981.
5. Documentele conferinței "Cercetări în optoelectronică", 1994, București, V. Dorogan, V. Brânzari, A. Snigur, G. Corotcencov, V. Coseac, "Aspecte tehnologice în confecționarea fotodiodelor selective optimizate pentru $\lambda = 1,06 \mu\text{m}$ ", p. 260-266.